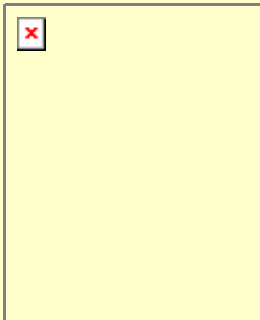


本期封面



1999年6期

栏目:

DOI:

论文题目: HFCVD生长金刚石薄膜中气体状态参数空间场模拟计算

作者姓名: 宋贵宏 孙超 黄荣芳 闻立时

工作单位: 中国科学院金属研究所, 沈阳 110015

通信作者: 宋贵宏

通信作者Email:

文章摘要: 本文对HFCVD过程中的气体状态参数空间场进行了模拟计算, 结果表明, 气体的温度, 体密度, 速度和质量流密度场是空间位置的函数, 在合适的位置, 可获得均匀的温度和质量流密度, 这些结果可为制备大面积均匀金刚石薄膜时工艺参数选择提供理论依据.

关键词: 金刚石薄膜 均匀生长 空间场 模拟计算

分类号: 0484

关闭